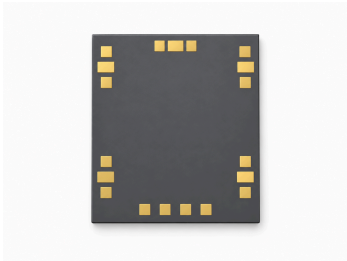


100–20000 MHz GaAs SP4T MMIC スイッチ・ベアダイ – IL –2 dB (標準値)

100–20000 MHz; 挿入損失 -2 dB (標準値); アイソレーション -50 dB (標準値).



RF 特性・TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
動作周波数	f	100	-	20000	100–20000	MHz
挿入損失	-	-	-2	-	-	dB
アイソレーション	-	-	-50	-	-	dB
入力 VSWR	-	-	1.3	-	-	-
出力 VSWR (オン)	-	-	1.3	-	-	-
出力 VSWR (オフ)	-	-	1.3	-	-	-

制御電圧

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
負電源静止電流	-	-	0.0018	-	-	A
入力駆動電流	-	-	0.0003	-	TTL = +5 V	A
入力Highレベル電圧	-	3	-	5	-	V
入力Lowレベル電圧	-	0	-	0.4	-	V
負電源電圧	-	-	-	-	-5	V

絶対限界値・限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大入力電力	-	-	-	27	dBm
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	85	°C
最大制御電圧	-	-	-	6	V
最小負電源電圧	-	-6	-	-	V

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	1.6 × 1.9 × 0.1	mm
平面外形公差	±100	μm

ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
5	RFout1	0.150 × 0.100
8	RFout2	0.150 × 0.100
15	RFout3	0.150 × 0.100
18	RFout4	0.150 × 0.100
10, 13	VE	0.100 × 0.100
11	VA	0.100 × 0.100
12	VB	0.100 × 0.100
1, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 19	GND	0.100 × 0.100

現在の発行記録 · 1.3 · 2026-10-27. 製品説明または編集内容を更新しました。置き換え対象の改訂版 1.2.

実装上の注意

VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 0; RF = RFin ⇔ RFout1 VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 0; RF = RFin ⇔ RFout2 VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 3.3; RF = RFin ⇔ RFout3 VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 3.3; RF = RFin ⇔ RFout4

パッド接続上の注意

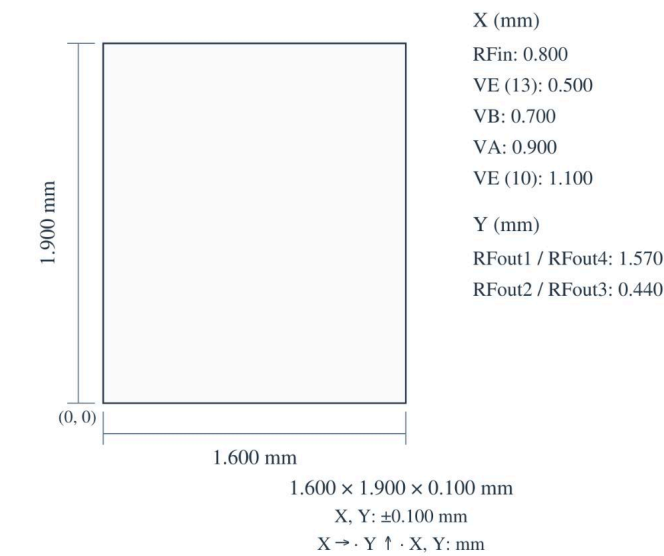
記載の GND パッドは試験用の接地パッドです。

機械参照図の適用範囲

原資料に基づく外形と明記された座標の参照図です。単位は mm。完全な製造図面やワイヤボンディング図ではありません。

外形寸法図

LCI-SW-100-20000-SP4T-D



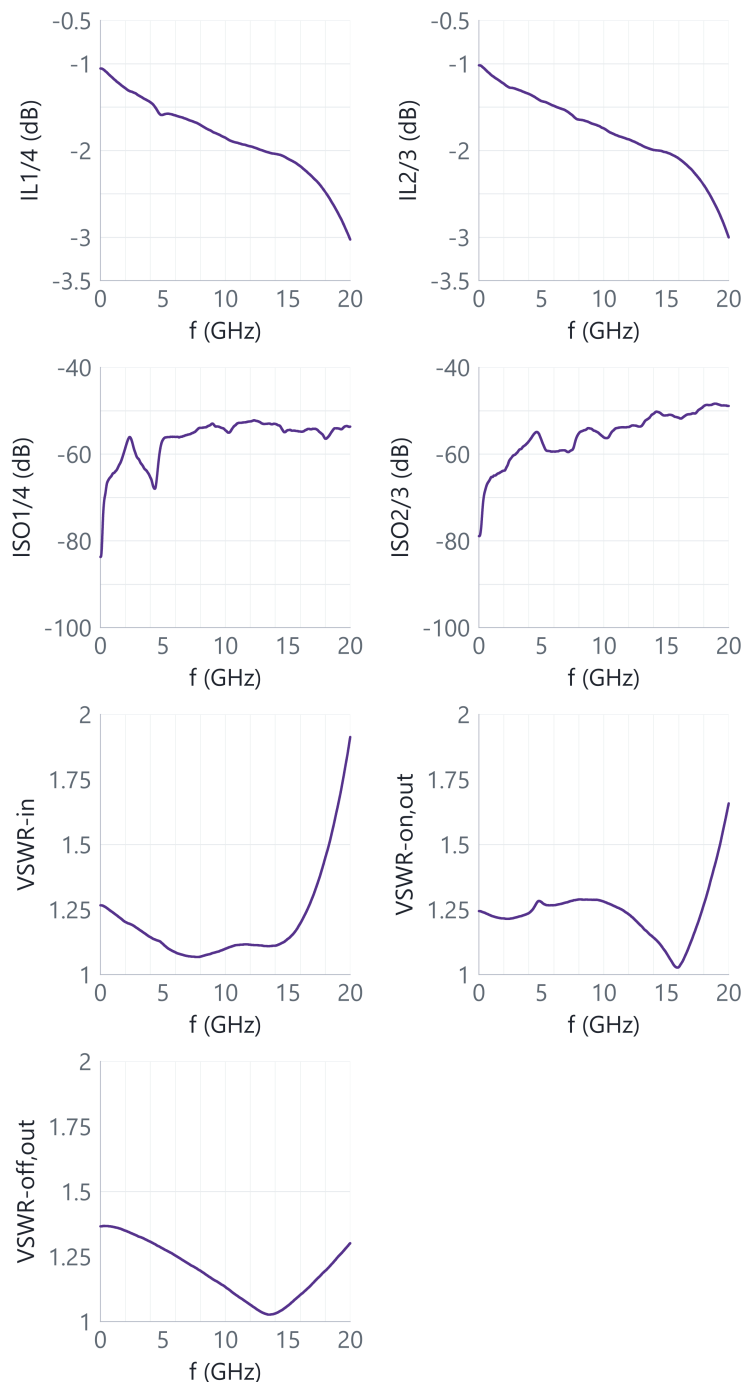
寸法の単位はすべて mm [in] です。

性能特性曲線

元のデータシートに掲載されたグラフです。各図に記載された動作条件と併せてご確認ください。

出力整合、入力整合、アイソレーション、挿入損失。

元図の曲線に基づいて描き直した図です。読み取り値は近似値です。



[出典](#)

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。